

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
*младшего научного сотрудника*  
в лаборатории Физики полупроводниковых гетероструктур  
*Вакансия VAC\_PTI\_JSР5\_11*

**Тематика исследований**

Исследования в области физики полупроводниковых гетероструктур, в том числе в области одномодовых полупроводниковых вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ, VCSEL) ближнего ИК-диапазона, а также исследование механизмов лимитирующих быстродействие ВИЛ, анализ токопрохождения и способа фиксации поляризации излучения.

**Трудовая деятельность**

Проведение научных исследований и разработок под руководством заведующего лабораторией согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам. Теоретическое и экспериментальное исследование механизмов лимитирующих быстродействие ВИЛ в режиме прямой токовой модуляции, исследования влияния времени жизни фотонов в резонаторе на динамические и статические характеристики ВИЛ, выявление способа фиксации поляризации излучения. Формулировка выводов по итогам проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, измерений. Повышение квалификации, выступление с докладами на научных семинарах и конференциях, подготовка публикаций по результатам исследований.

**Особенности трудовой деятельности**

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории фотоэлектрических преобразователей на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к их квалификации.

- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:  
Web of Science (шт.) не менее 30, Scopus (шт.) не менее 30.
- Опыт научной работы: не менее 6 лет
- Индекс Хирша не ниже 3
- За последние 5 лет: участие в не менее чем 9 проектах, поддержанных отечественными или зарубежными научными фондами, а также личное участие с докладами в не менее чем 12 всероссийских или международных конференциях.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;

характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).